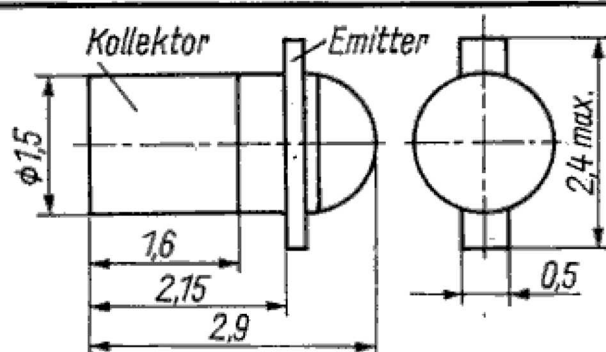


SP 211

Silizium-npn-Planar-Fototransistor in einem Metall-Keramik-Gehäuse mit linsenförmigem Glasfenster für frontalen Lichteintritt.

Durch seine günstigen äußeren Abmessungen wird der Aufbau von Fototransistorzeilen und -matrizen mit einem Rastermaß von 2,5 mm möglich.

Bauform 10



Grenzwerte bei $\theta_a = -65 \dots 125 \text{ }^\circ\text{C}$

Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CE}	50 V
Kollektor-Emitter-Spitzenspannung	U_{CEM}	50 V
Emitter-Kollektor-Spannung	U_{EC}	7 V
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	50 mW
Betriebstemperatur	θ_a	$-65 \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	θ_{stg}	$-65 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$

Kennwerte bei $\theta_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

	min.	typ.	max.	
Kollektorstrom				
$E_e = 0 \text{ lx}, U_{CE} = 25 \text{ V}$		4	100	nA
Kollektorstrom bei				
$E_v = 1\,000 \text{ lx}^1), U_{CE} = 5 \text{ V}$				
SP 211	I_C	0,25		mA
SP 211 A	I_C	0,40	0,80	mA
SP 211 B	I_C	0,63	1,25	mA
SP 211 C	I_C	1,00	2,00	mA
SP 211 D	I_C	1,60	3,20	mA

Wellenlänge der max. spektralen Empfindlichkeit $\lambda_{s_{max}}$ 800 850 950 nm

Öffnungswinkel der Richtcharakteristik²⁾ Θ 20 0

Kapazität C_{tot} 3,2 pF

$E_e = 0 \text{ lx}, U_{CE} = 5 \text{ V}$
Schaltzeiten $I_C = 800 \text{ } \mu\text{A}$,
 $U_B = 35 \text{ V}, R_L = 1 \text{ k}\Omega$

Verzögerungszeit t_d 5 μs

Anstiegszeit t_r 10 μs

Speicherzeit t_s 1,5 μs

Abfallzeit t_f 10 μs

Thermischer Widerstand R_{th} 2 K/mW

¹⁾ Gemessen mit einer Wolframfadenlampe bei einer Farbtemperatur von 2 856 °K (Normlichtart) in Richtung der geometrischen Achse.

²⁾ Abfall der Empfindlichkeit auf 50 % des Wertes in optischer Achse.